**Волошок, Татьяна Николаевна.**

**Фотоиндуцированный парамагнетизм примесных центров в узкощелевых полупроводниках A IV B VI : диссертация ... кандидата физико-математических наук : 01.04.09. - Москва, 2000. - 112 с.**

**Оглавление диссертациикандидат физико-математических наук Волошок, Татьяна Николаевна**

**Введение.**

**Глава I. Свойства РЬТе и Pb}.xSnxTe, обусловленные глубокими примесными центрами Ga я In.**

**§ 1Л. Кристаллическая структура, энергетический спектр и примесные состояния в полупроводниках AIVBVI.**

**1Л Л. Кристаллическая структура и энергетический спектр.**

**1.1.2. Собственные дефекты и примеси.**

**§1.2. Системы с отрицательной энергией взаимодействия электронов. Задержанная фотопроводимость.**

**1.2.1. Концепция отрицательной энергии Хаббарда.**

**1.2.2. Модели примесных центров в AiVBVi.**

**1.2.3. Влияние примесей на упругие свойства полупроводников AivByi.**

**§1.3. Магнитные свойства полупроводников AIVBVI.**

**1.3.1. Магнитная восприимчивость РЬТе и SnTe.**

**1.3.2.Магнитная восприимчивость Pb}.xSnxTe.**

**1.3.3.Магнитная восприимчивость РЬТе и РЪ¡.xSnxTe, легированных элементами III группы.**

**Краткие выводы и постановка задачи исследования.**

**Глава II. Экспериментальные методы исследований.**

**§ 2.1. Объекты исследования.**

**§ 2.2. Электрофизические измерения.**

**§ 2.3. Электромагнитное возбуждение ультразвука.**

**§ 2.4. Методы измерения магнитной восприимчивости.**

**Глава III. Метастабильные магнитные состояния**

**In и Ga в полупроводниках AIVBVi.**

**§3.1. Задержанная фотопроводимость в РЬо^по^Те:!!! и РЬТе:Оа.**

**§ 3.2. Аномалии упругих свойств РЬТе:Оа.**

**§ 3.3. Влияние примесей III группы на магнитную восприимчивость РЬТе и Pbo.75Sno.25Te.**

**§ 3.4. Модель фотоиндуцированного парамагнетизма примесных центров в узкощелевых полупроводниках.**

**Выводы.**